

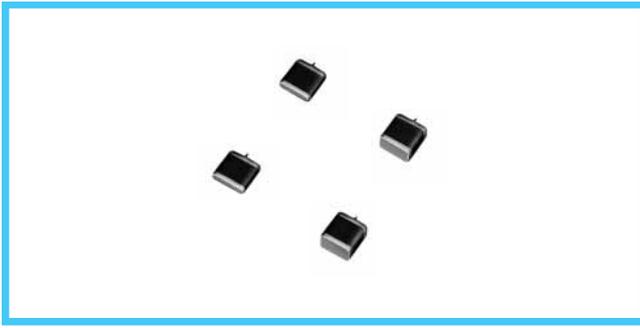
F72 薄形 树脂外装芯片

F75 大容量 树脂外装芯片

FRAMELESS™

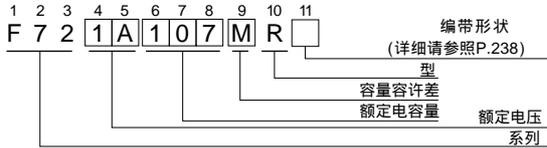


●RoHS指令(2002/95/EC)已对应完毕

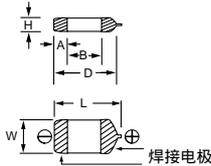


F72

■品号编码体系 (例: 10V 100μF)



■尺寸图表



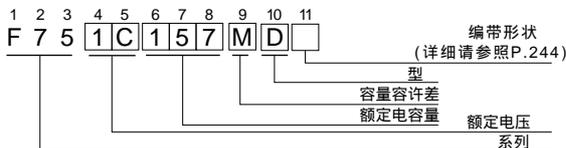
■尺度

型记号	L	W	H	A	B	(D)
R	7.2 ± 0.3	6.0 ± 0.3	1.2 ± 0.3	1.3 ± 0.4	3.8 ± 0.6	(6.2)

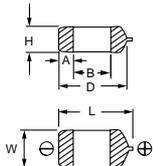
() 内为参考值

F75

■品号编码体系 (例: 16V 150 μF)



■尺寸图表



■尺度

型记号	L	W	H	A	B	(D)
C	7.1 ± 0.3	3.2 ± 0.3	2.5 ± 0.3	1.3 ± 0.3	3.6 ± 0.6	(6.0)
D	7.3 ± 0.3	4.3 ± 0.3	2.8 ± 0.3	1.3 ± 0.4	3.9 ± 0.6	(6.4)
R	7.2 ± 0.3	6.0 ± 0.3	3.5 ± 0.3	1.3 ± 0.4	3.8 ± 0.6	(6.2)

() 内为参考值

■标准额定值

F72

Cap.(μF)	V				
	品号编码	4 0G	6.3 0J	10 1A	16 1C
33	336				R
47	476			R	R
68	686		R	R	R
100	107	R	R	R	
150	157	R	R	R	
220	227	R	R		
330	337	R			

■仕様

項目	性能	
分类温度范围	-55 ~ +125°C (额定温度: +85°C)	
额定静电容量容许差	± 20%, ± 10% (120Hz)	
损失角正切值 (120Hz)	33-68μF	6%以下
	100μF~	8%以下
	150μF	10%以下
	220μF-330μF	12%以下
E.S.R (100kHz)	33μF	0.90Ω
	47μF	0.80Ω
	68μF	0.75Ω
	100μF~	0.70Ω
漏损电流	• 0.01CV 或 0.5 μ A 中的较大值以下 (20、1分値)	
	• 0.1CV 或 5 μ A 中的较大值以下 (85、1分値)	
根据不同温度的静电容量变化	+15% 以下 . (+125°C)	
	+10% 以下 . (+85°C)	
高温高湿 (恒温)	试验条件: 40°C、90-95% R.H. 放置500小时	
	静电容量变化率-----试验前的值 ±10% 以内	
温度突变	试验条件: -55°C 30分 / +125°C 30分 5次	
	静电容量变化率-----试验前的值 ±5% 以内	
焊接耐热	试验条件: 260°C 10秒 回流, 260°C 10秒 浸渍	
	静电容量变化率-----试验前的值 ±5% 以内	
浪涌*	试验条件: 在85 下通过33 施加1000次浪涌电压	
	每次充电30秒, 放电30秒	
耐久性*	试验条件: 在85 下通过3 印加额定电压2000小时	
	在125. C下通过3 印加额定电压 2000小时	
粘着性	在氧化铝基板上焊接, 对着无电极部件	
	侧没有面的中央, 向安装基板水平加压	
端子强度	将产品安装面朝下, 对距中心45mm处的	
	点进行支撑, 并用规定的夹具对其中	

* 关于浪涌、125 降低电压, 请参照P.27

F75

Cap.(μF)	V			
	品号编码	4 0G	6.3 0J	10 1A
68	686			C
100	107			C
150	157			D
220	227		C	D
330	337	C	C·D	D
470	477	C·D	D	R
680	687	D	D·R	
1000	108	D·R	R	
1500	158	R		
2200	228	R		